

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕРХЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В КРИСТАЛЛАХ АНТРАЦЕНА

М. Д. Галакин, Ш. П. Хак-Магометова, З. А. Чумиков

УДК 535.372-4:547.672.1

Измерено поляризационное отношение для вибронной линии  $23692 \text{ см}^{-1}$  в спектре люминесценции кристаллов антрацена, для которого ранее была обнаружена сверхлюминесценция при возбуждении импульсами азотного лазера. Показано, что поляризационное отношение уменьшается при увеличении интенсивности возбуждения.

В /I-2/ нами было обнаружено, что при возбуждении кристалла антрацена азотным лазером при температуре  $4,2^{\circ}\text{K}$  наблюдается сверхлюминесценция в вибронной линии  $23692 \text{ см}^{-1}$ . Оценки возможного коэффициента усиления показали, что наблюдавшаяся люминесценция не может быть объяснена усилением люминесценции на толщине кристалла. Было сделано предположение, что усиление происходит при распространении излучения вдоль тонкого возбужденного слоя вблизи поверхности кристалла. Наблюдаемая в направлении нормали сверхлюминесценция была объяснена дифракцией в тонком возбужденном слое.

Как известно, излучение твердотельных лазеров обычно бывает полностью линейно-поляризовано, если исходная линия люминесценции имеет частичную поляризацию. Это естественно объясняется тем, что более интенсивная компонента линии люминесценции испытывает большее усиление и раньше достигает порога генерации. Таким образом, при сверхлюминесценции в обычных условиях можно ожидать увеличения степени поляризации.

В настоящей работе мы измерили изменение поляризационного отношения для линии  $23692 \text{ см}^{-1}$ , усиливающейся при увеличении ин-

тенсивности возбуждения. Методика измерения спектров была такой же, как и в /1,2/. Линии луминесценции возбуждались азотным лазером ( $\lambda = 337$  нм), и измерения проводились при  $4,2^{\circ}\text{K}$ .

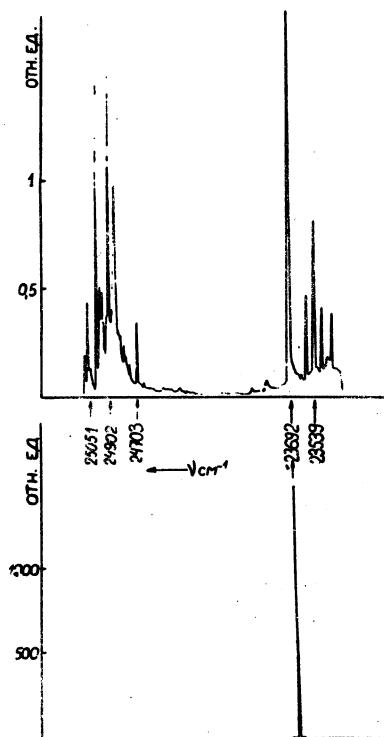
Для измерения поляризационного отношения перед щелью спектрометра ДФС-12 устанавливалась поляризатор. Кристалл ориентировался так, чтобы его плоскость  $\sigma$  была перпендикулярна оптической оси прибора, а кристаллографические оси  $a$  и  $b$  составляли угол  $45^{\circ}$  с вертикалью. Чтобы не учитывать деполяризующие действия прибора, измерения производились для двух положений поляризатора — совпадающих с осью  $a$  и осью  $b$ . При такой ориентации кристалла пропускание спектрометра было одинаково для двух указанных направлений поляризации.

Измерения поляризационного отношения производились на двух линиях спектра линии луминесценции актранена — головной линии  $25051\text{ cm}^{-1}$  и усиливавшейся вибронной линии  $23692\text{ cm}^{-1}$ . При увеличении интенсивности возбуждения в семь раз линии  $25051\text{ cm}^{-1}$  усиливалась только в 3,5 раза (из-за нелинейного тушения), а интенсивность линии  $23692\text{ cm}^{-1}$  возросла в 26 раз. Поляризационное отношение для  $25051\text{ cm}^{-1}$  не изменилось. Для линии  $23692\text{ cm}^{-1}$  наблюдалась деполяризация, поляризационное отношение уменьшилось с 6,8 до 1,8. Для разных кристаллов эти значения несколько различались. В некоторых случаях оно уменьшалось до 1, т.е. происходила полная деполяризация.

Этот результат подтверждает предположение о том, что усиление линии луминесценции происходит не поперек, а вдоль возбужденного слоя, причем нет преимущественного направления для усиления. По-видимому, распространение излучения вдоль слоя происходит с участием полного отражения на задней поверхности кристалла, противоположной возбужденному слою. В пользу последнего говорит то, что мы не наблюдали эффект усиления на толстых (скажем порядка десятых мм) кристаллах, хотя их спектры линии луминесценции не отличались от спектров тонких пластинок толщиной порядка десятых мкм, полученных сублимацией.

Эффект усиления линии луминесценции наблюдался нами не только на свободно укрепленных тонких кристаллах (в "конвертике"), но и на кристаллах, посаженных на оптический контакт на кварцевую подложку, хотя спектр линии луминесценции при этом сильно покажался. Усиление

наблюдалось также и у тонких кристаллов (в "конвертике"), спектры которых отличаются от обычного присутствием ряда сильных линий, которые связываются с так называемыми 0-центрами или локализован-



Р и с. I. Спектр люминесценции кристалла антрацена при  $T = 1.56^{\circ}\text{K}$ , вверху – при слабом возбуждении, внизу – при сильном возбуждении. Интенсивность возбуждения отличается в 25 раз.

ными экситонами. На рис. I приведены спектры люминесценции одного из таких кристаллов.

В связи с обсуждением возможности проявления взаимодействия экситонов в спектре люминесценции при пониженных температурах, на них были исследованы спектры кристаллов антрацена при  $T = 1.56^{\circ}\text{K}$ . Эффект усиления у тонких кристаллов наблюдается при  $T = 1.56^{\circ}\text{K}$  при со-

лее низких (~ в 3 раза) интенсивностях возбуждения, чем при  $4,2^{\circ}\text{K}$ , что связано, очевидно, сужением линии. На толстых кристаллах эффект усиления даже и при  $1,56^{\circ}\text{K}$  не наблюдался. Ни для тонких, ни для толстых кристаллов вплоть до предельных разрушающих кристалл интенсивностей новых линий в спектре не было обнаружено.

Авторы благодарят А. Н. Савченко и В. Н. Сморчкова за помощь при наладке установки.

Поступила в редакцию  
26 апреля 1973 г.

#### Л и т е р а т у р а

1. М. Д. Галанин, Ш. Д. Хан-магометова, З. А. Чижикова. Письма в ЖЭТФ, 16, 141 (1972).
2. М. Д. Галанин, Ш. Д. Хан-Магометова, З. А. Чижикова. Изв. АН СССР, сер. Физическая, 37, 298 (1973).